## 多色 InAs/GaAs 量子ドットによる近赤外広帯域 SLD 光源の作製

Broadband near-infrared SLD based on stacked multi-color InAs/GaAs quantum dots

和歌山大シスエ<sup>1</sup>, NEC<sup>2</sup>, 物材機構<sup>3</sup>, シェフィールド大<sup>4</sup>

<sup>o</sup>保田拓磨<sup>1</sup>, 尾崎信彦<sup>1</sup>, 大河内俊介<sup>2</sup>, 池田直樹<sup>3</sup>, 渡辺英一郎<sup>3</sup>, 杉本喜正<sup>3</sup>, R.A. Hogg<sup>4</sup> Wakayama Univ.<sup>1</sup>, NEC Corp.<sup>2</sup>, NIMS<sup>3</sup>, Univ. Sheffield<sup>4</sup>

<sup>O</sup>T. Yasuda<sup>1</sup>, N. Ozaki<sup>1</sup>, S. Ohkouchi<sup>2</sup>, N. Ikeda<sup>3</sup>, E. Watanabe<sup>3</sup>, Y. Sugimoto<sup>3</sup>, R. A. Hogg<sup>4</sup>

E-mail: ozaki@sys.wakayama-u.ac.jp

【はじめに】光コヒーレンストモグラフィ(OCT)は非侵襲な生体・医療用断層イメージング技術で あり、生体内吸収が少ない近赤外波長域において低コヒーレンス(広帯域)な光源を用いることで高 分解能と高深達度を得ることができる。我々はこれまでに、OCT 光源に有用な発光材料として期 待される InAs 量子ドット(QD)の発光波長制御技術を開発してきた[1-3]。今回、歪緩和層(SRL)導 入により 1.2-1.3µm にかけて発光中心波長を制御した InAs-QD を融合し、OCT 光源として実用的 な広帯域 SLD(superluminescent diode)素子を作製した。

【実験】サンプルは分子線エピタキシー(MBE)法により作製した。GaAs 基板上に S-K モードで InAs-QD を成長し、成長後の QD に SRL として  $In_{0.2}Ga_{0.8}As$  層を異なる厚み(0, 1.3, 2.4, 4.1 nm)で積 層した QD 層を 240nm 厚の GaAs 活性層内に 4 層積層(48 nm 間隔)した。活性層を厚さ 1.5 $\mu$ m の p-/n-Al<sub>0.35</sub>Ga<sub>0.65</sub>As クラッド層で挟み、サンプル成長後にフォトリソグラフィーとドライエッチン グによりリッジ型導波路(RWG)を形成した。RWG の高さ、幅は約 2.0、25 $\mu$ m であり、長さは約 1mm とした。n 層側電極は Ti/Pt/Au、p 層側電極は Ni/AuGe/Ni/Au を用いた。作製した RWG から のエレクトロルミネッセンス(EL)を室温にて測定した。

【結果】Fig. 1 に注入電流密度(J)に対する EL スペクトルを示す。波長制御された InAs-QDs による広帯域な発光が得られ、J=36.8A/cm<sup>2</sup> で EL の帯域幅は約 140nm であった。発光中心波長は基底準位(GS)間発光で約 1220~1300nm、第一励起準位間(ES)発光で約 1150~1200nm である。J に対する EL 積分強度プロットを Fig. 2 に示す。積分強度が J に対し superlinear な増加を示しており、SLD の特性が現れていると考えられる。また、特定の発光波長における EL 強度も J に対し superlinear な関係を示し、J < 30A/cm<sup>2</sup> においては GS 発光の gain が ES 発光の gain よりも大きく、J ≥ 30A/cm<sup>2</sup> では逆に ES 発光の gain が増加した。キャリア注入により GS のフィリングが起き、次いで ES からの発光が強くなった結果と考えられる。以上の結果から、QD ベースの SLD 発光が確認できた。

【謝辞】本研究は、科研費(23760015, 25286052)およびキャノン財団の助成を受けた。また、微細加工は NIMS 微細加工プラットフォームの支援を受けて実施された。

## References

[1] N. Ozaki et al., IEICE Trans. Electron. E95-C 247 (2012). [2] Y. Hino et al., JCG in press.

[3]中谷擁平他 第 60 回応用物理学会 2013 春季学術講演会 29a-PB7-2



Fig. 1 EL spectra from a fabricated RWG including 4-stacked multi-color InAs-QDs with different *J*.



Fig. 2 Integrated EL intensities plotted against J.